

ПРОТОКОЛ № 3/2019
Заседания Конкурсной Комиссии
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного автономного научного учреждения
Института сверхвысококачественной полупроводниковой электроники
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук

г. Москва

28 августа 2019 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии	- доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН - С.А.Гамкрелидзе
Заместитель председателя комиссии	- кандидат физико-математических наук, доцент заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН - Д.С. Пономарев
Секретарь комиссии	- кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН - Р.А. Хабибуллин
Члены комиссии:	- кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов - доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» - Ю.В. Колковский - член-корреспондент РАН, директор ФТИАН имени В.К.Валиева РАН - В.Ф. Лукичев - главный научный сотрудник, профессор кафедры Электроники НИЯУ «МИФИ», доктор технических наук - Д.В.Громов

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

Повестка дня: Проведение конкурса на замещение вакантной должности ведущего научного сотрудника лаборатории № 106 «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе

Слушали:

1. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса, от Редькина Сергея Викторовича для избрания его на должность ведущего научного сотрудника лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе». Директор зачитал характеристику Редькина С.В., подписанную заведующим

лаборатории № 106 Павловым А.Ю. В ней, в частности отмечается, что Редькин С.В. является автором 40 изобретений и 40 научных публикаций. За время работы проявил себя как сотрудник, способный самостоятельно ставить и решать научные задачи. Он являлся заместителем руководителя ОКР «Теплоотвод», руководителем НИР по разработке установки и технологии формирования слоев Si-SiC на Si. За время работы в лаборатории им получено 6 патентов и подана одна заявка на изобретение по тематике проводимых работ. Он принимает участие в подготовке молодых кадров исследователей и разработчиков технологических процессов формирования слоев и топологии приборов СВЧ полупроводниковой электроники, работающих в экстремальных условиях.

С.В. Редькин неоднократно выезжал за рубеж по обмену научных сотрудников между РАН и национальными академиями – Болгария, Чехия, Германия, Франция, Великобритания.

С.В. Редькиным предложена оригинальная технология формирования слоев кубического карбида кремния на кремнии в СВЧ плазме. С.В. Редькиным предложен новый принцип построения плазмохимических реакторов для обработки пластин большого диаметра и новый принцип создания технологической плазмы.

В последнее время С.В. Редькин предложил и разрабатывает новое направление в науке - лазерные плазмохимические процессы.

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам.

2. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, на сайт [www.ученые – исследователи.рф](http://www.ученые-исследователи.рф) поступила заявка от Зембатовой Бэллы Владимировны 1952 г.р. для избрания по конкурсу на должность ведущего научного сотрудника лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе.

Однако в Конкурсную комиссию был представлен не полный пакет документов, в связи с этим членами Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию претендента Зембатовой Б.В.

Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

Постановили:

По 1-му пункту повестки дня:

1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности ведущего научного сотрудника лаборатории № 106 лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, маломощных и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе состоявшимся в объявленные сроки.

3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании балльной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- ведущего научного сотрудника лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, маломощных и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе – Редькина Сергея Викторовича.

Председатель Конкурсной комиссии
д.т.н., профессор
Секретарь Конкурсной комиссии
к.ф.-м.н.

«28» августа 2019 г.



С.А. ГамкRELИДзе

Р.А. Хабибуллин